

Micron 的混合内存立方在下一代超级计算机应用中获得高度赞扬

Micron 新款设备支持千万亿次 (Petascale) 超级计算机，突破内存墙以解决行业在超级计算机领域面临的巨大挑战

爱达荷州博依西，2013 年 11 月 8 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology, Inc., (纳斯达克代码: MU) 今日宣布正在规划将其混合内存立方 (HMC) 适应于 petascale 超级计算机系统，这代表着内存技术向前迈出的巨大的一步。HMC 是专门为需要访问低能耗、高带宽内存的应用而设计的，这些是超级计算机最重要的要求。其他应用包括数据包处理、数据包缓冲或存储、以及处理器加速等。

在 11 月 19 至 21 日在丹佛举办的“2013 超级计算大会”上，Micron 和全球超级计算领袖 Fujitsu 均将推出各自的展示板，以展示 Fujitsu 下一代超级计算机样机采用的 HMC 设备的特点。

超级计算是一项使科学家和工程师能处理复杂模拟的重要技术，这些模拟能推动研究和开发，使其能探索我们宇宙结构的基本问题。处理这种级别的问题需要极高的数据移动能力。采用 HMC 释放超级计算机内多核处理器架构的潜力可取得非凡的性能和效率。

“Fujitsu 的设计师和工程师们很早就看到混合内存立方的价值，这种内存有助于将他们的系统提升至下一级的水平”，Micron 公司 DRAM 解决方案集团副总裁 Brian Shirley 说。“我们期盼着帮助 Fujitsu 立即提高处理最先进计算问题的能力”。

“HMC 给我们的系统设计师们留下了非常深刻的印象，因为它使新的内存系统设计能支持我们对带宽和超级紧凑的外形尺寸日益增长的要求，并优化了每内存位的能耗”，Fujitsu 下一代计算技术部主管 Yuji Oinaga 说，“关于应用软件性能和效率的优化，最重要的提高 B（字节）/F（每秒浮点运算率 FLOPS）比，而 HMC 代表了超级计算用内存的新性能标准”。

这是一个行业性的突破，HMC 采用了先进的硅穿孔（TSV）垂直导连技术-即将各个芯片的堆栈电气地连接在一起，并采用 Micron 先进的 DRAM 共同构成高性能逻辑电路。Micron 的 HMC 带宽史无前例的高，可达 160GB/s，而每位功耗比采用现有技术的器件少 70%，这大幅度地降低了用户的总拥有成本（TCO）。

业界领袖者和有影响人士认为 HMC 为 DRAM 的性能改进率与处理器数据能耗率之间日益增大的差距提供了一个期待已久的答案。Micron 的 HMC 最近被主流电子刊物 EDN 和 EE 时报命名为“年度最佳内存产品”。

Micron 预计将于 2014 年下半年对容量为 2GB 和 4GB 的 HMC 设备进行批量生产。

关于 Micron

Micron Technology, Inc., 是全球领先的先进半导体解决方案供应商之一。通过它遍布全球的运营, Micron 为先进的计算、用户、网络、嵌入式和移动产品生产和销售全套固态硬盘、DRAM、NAND 和 NOR 闪存, 以及其他创新的存储器技术、封装方案和半导体系统。Micron 的普通股在纳斯达克上市交易, 代码是 MU 欲了解有

www.micron.com 的更多信息, 请

(C)2013 Micron Technology, Inc.版权所有。信息若有修改恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽标为 Micron Technology, Inc.的商标。其他商标分别为其各自所有者财产。本新闻稿包含有关混合内存立方的样品供货和批量生产的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与前瞻性陈述中包括的内容不同。请参考 Micron 和证券交易委员会定期发布的汇总文件, 特别是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。这些文件包含并确定导致汇总文件中的内容与前瞻性陈述不同的重要因素(见“某些因素”)。尽管我们认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的, 但我们不能保证其未来结果、活动程度、性能或成就。

联系方式: Micron 媒体联系人:

Scott Stevens

+1-512-288-4050

sstevens@micron.com